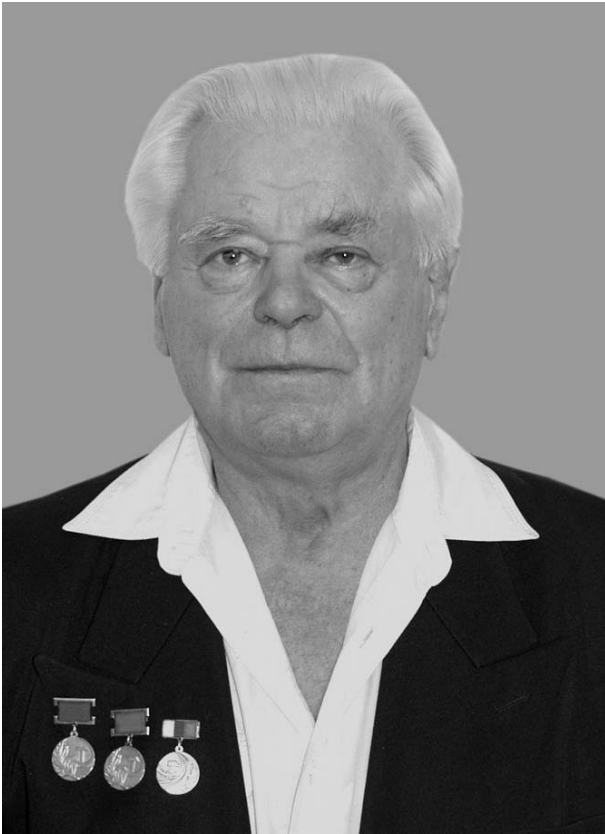


## К 80-ЛЕТИЮ ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА СТАФЕЕВА



1 января 2009 года исполняется 80 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора Виталия Ивановича Стафеева.

В.И. Стафеев – выдающийся ученый в области физики полупроводниковых приборов, сенсоров, микро- и фотоэлектроники, автор более 600 научных работ, в том числе 12 монографий и 90 изобретений.

В.И. Стафеев родился в селе Красносельское Ленинского района Акмолинской области Казахской ССР. В 1952 г. после окончания физико-математического факультета университета в г. Алма-Ате В.И. Стафеев начал работать в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе АН СССР. В 1964 г. он был назначен первым директором вновь созданного в г. Зеленограде НИИ физических проблем Минэлектронпрома. В 1969 г. В.И. Стафеев перешел на работу в НИИ прикладной физики Миноборонпрома (ныне Государственный научный центр РФ – Федеральное Государственное унитарное предприятие «НПО «Орион»).

В.И. Стафеев внес заметный вклад в начальный этап становления отечественной силовой полупроводниковой техники (1958–1959 гг.). Им предложены принципы действия новых полупроводниковых приборов и функциональных логических интегральных схем, устройств приема, обработки и воспроизведения изображений. В их числе высокоэффективные сенсоры, обладающие высокой чувствительностью к магнитному полю, давлению, механическим воздействиям, электромагнитному излучению от ультрафиолетового до субмиллиметрового, ядерному излучению.

В работах В.И. Стафеева значительное место занимают исследования фундаментальных процессов в диэлектрических средах, в жидких кристаллах, свойств молекулярных пленок, моделирование нейронов и процессов обработки информации в нейронных сетях. На этой основе В.И. Стафеевым разработаны принципы функциональной микроэлектроники с использованием инжекционно-плазменной объемной связи в полупроводниковых структурах, разработана новая схемотехника.

Комплексные исследования оптических явлений при разогреве электронного газа в полупроводниках, проведенные под руководством В.И. Стафеева, привели к созданию высокоэффективных лазеров дальнего инфракрасного диапазона с управляемой длиной волны излучения, фотоприемников для этой области спектра и СВЧ-модуляторов света.

Под руководством В.И. Стафеева проведена разработка и организовано промышленное производство нового перспективного полупроводника на основе кадмия, ртути и теллура (КРТ) и высокоэффективных фотоприемников на его основе для ИК-диапазона спектра, в том числе матричных для перспективных систем тепловидения и теплопеленгации различного назначения.

Научные интересы В.И. Стафеева в настоящее время включают такие разнообразные темы, как перенос тепла инжектированными носителями (пионерские работы В.И. Стафеева опубликованы в 1974 г.) и создания на этом эффекте термоэлектрических охлаждающих устройств, в том числе на основе КРТ; исследования новых физических явлений: электрических, термоэлектрических, термо- и электрогравитационных и других на границе формирующихся фаз; исследование процессов образования зародышей новых фаз минимальных размеров (фазоны) и мельчайших

кластеров другой фазы (наночастицы) в различных средах.

Участие В.И. Стафеева в работах по созданию первой советской атомной подводной лодки (1958–1959 гг.), отмечено медалью “За трудовую доблесть”; он является почетным работником промышленности вооружений.

За выдающиеся достижения в области прикладной физической оптики В.И. Стафеев награжден медалью А.А. Лебедева. За свои работы в области полупроводниковой электроники В.И. Стафеев дважды был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР (1976 г. и 1982 г.) и звания лауреата Государственной премии Российской Федерации (2002 г.)

Виталий Иванович всегда вел большую педагогическую работу. Он был профессором Ленинградского политехнического института, заведующим кафедрой Московского физико-технического института (МФТИ). В настоящее время он является профессором МФТИ.

В.И. Стафеев ведет активную научно-организационную деятельность. Под его руководством и при его непосредственном участии проведено много научных конференций, симпозиумов, семинаров. Виталий Иванович являлся членом редакционных коллегий журналов “Радиотехника и электроника”, “Физика и техника полупроводников”, принимал участие в создании журнала “Микроэлектроника”, входил в составы экспертного совета ВАК и экспертного совета Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР.

Виталий Иванович – глава большой научной школы, признанной у нас в стране и за рубежом. Среди его учеников 25 докторов и более 70 кандидатов наук, в том числе несколько лауреатов Государственных премий СССР и РФ. Его ученики успешно работают во многих городах России и стран СНГ.

Многочисленные коллеги, ученики, коллектив редколлегии журнала “Радиотехника и электроника” поздравляют Виталия Ивановича с юбилеем и желают ему здоровья и дальнейших творческих успехов.